

УДК 539.184:544.18

**АНАЛИЗ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ СПЕКТРОВ РЕНТГЕНОВСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ  
ЗА К-КРАЕМ НИКЕЛЯ В КОМПЛЕКСЕ  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$**

© 2007 А.В. Солдатов<sup>1\*</sup>, А.Н. Кравцова<sup>1</sup>, Л.Н. Мазалов<sup>2,3</sup>, С.В. Трубина<sup>2,3</sup>,  
Н.А. Крючкова<sup>2</sup>, Г.Б. Сухарина<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

<sup>2</sup>Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск

<sup>3</sup>Новосибирский государственный университет

Статья поступила 5 июня 2007 г.

Измерены спектры ближней тонкой структуры (XANES — X-ray absorption near edge) K-края никеля в комплексе  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$ . Проведены расчеты теоретических спектров XANES K-края никеля на основе метода полного многократного рассеяния и метода коначных разностей, при этом расчет потенциала был выполнен как в рамках *muffin-tin* приближения, так и вне его. Показана важность учета не-*muffin-tin* эффектов при моделировании теоретического Ni K-XANES-спектра для комплекса  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$ : оказалось, что хорошее согласие теории с экспериментом достигается только при проведении расчетов в полном потенциале (без учета *muffin-tin* приближения для формы потенциала).

**Ключевые слова:** комплекс  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$ , XANES, *muffin-tin* приближение.

**ВВЕДЕНИЕ**

В последнее время для изучения структурных особенностей различных веществ и материалов все шире привлекается новый метод — рентгеноспектральный структурный анализ [1, 2], основанный на изучении тонкой структуры рентгеновских спектров поглощения. Использование мощных источников рентгеновского излучения и соответствующих новых методов теоретического расчета ближней и далекой тонкой структуры рентгеновских абсорбционных спектров (XANES и EXAFS — extended X-ray absorption fine structure) [3—5] предоставляет исследователям эффективный метод изучения структуры молекул, комплексов, аморфных веществ, растворов и т.д.

В настоящем сообщении рассмотрена возможность использования различных методик расчета XANES для изучения структуры внутрикомплексных соединений (дитиолатов) [6, 7] на примере комплекса  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$ .

Дитиолаты переходных 3d-металлов находят широкое применение в химии экстракции, аналитической химии, радиохимии [8]. Особенностью строения этих комплексов является наличие металлоузла с плоскоквадратной координацией хелатных циклов, что обусловливает возможность увеличения координатного числа атома металла [9]. Соответствующие особенности строения этих соединений диктуют необходимость подбора способов расчета XANES-спектров, в частности учета не-*muffin-tin* эффектов [5].

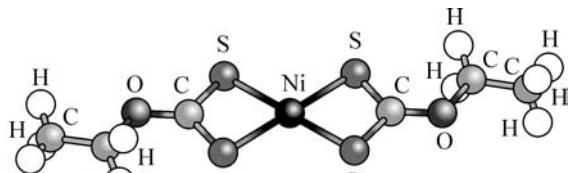
**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

Измерение Ni K-XANES-спектра комплекса  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$  проводили с использованием синхротронного излучения (СИ) накопителя ВЭПП-3 Института ядерной физики им. Г.И. Буджера

\* E-mail: soldatov@rsu.ru

Рис. 1. Структура комплекса Ni(EtOCS<sub>2</sub>)<sub>2</sub>

СО РАН. Режим работы накопителя во время измерений: энергия 2 ГэВ, ток 100—150 мА. В качестве мониторирующего и регистрирующего детекторов использовали ионизационные камеры с He/Ar наполнением. В качестве двухкристального монохроматора использовали моноблочный прорезной монокристалл кремния (плоскость (111)).



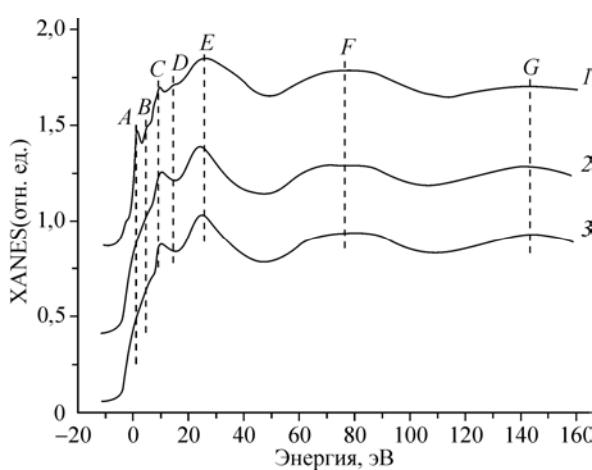
#### МЕТОДИКА РАСЧЕТА

В настоящей работе теоретический анализ XANES спектров за *K*-краем никеля в комплексе Ni(EtOCS<sub>2</sub>)<sub>2</sub> был проведен в рамках двух подходов: на основе метода полного многократного рассеяния в прямом пространстве (с использованием программных комплексов FEFF8.2 [10, 11] и FDMNES [12]) и на основе метода конечных разностей (с помощью программы FDMNES). К преимуществам программы FDMNES можно отнести возможность проведения расчетов в полном потенциале (без использования *muffin-tin* приближения [13]). В то же время известно, что именно учет не-*muffin-tin* эффектов является важным и приводит к значительным изменениям в спектрах XANES для неплотноупакованных структур [14], к которым относится и комплекс Ni(EtOCS<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.

Комплекс Ni(EtOCS<sub>2</sub>)<sub>2</sub> состоит из 23 атомов. Его структура показана на рис. 1. С помощью программы FEFF8.2 рассчитывали XANES-спектры атомного кластера, включающего 23 атома, т.е. в расчет были включены все атомы, входящие в состав комплекса Ni(EtOCS<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. Координаты атомов, используемые в расчете, представлены в таблице. Ранее было показано, что при использовании метода конечных разностей (FDM) сходимость теоретических спектров XANES по числу атомов в кластере достигается быстрее, чем в методе полного многократного рассеяния (FMS), кроме того, метод конечных разностей для расчета спектров XANES требует значительного времени вычисления и привлечения больших вычислительных ресурсов, поэтому расчеты спектров поглощения *K*-края никеля на основе метода FDM (с помощью программного кода FDMNES) были проведены для атомного кластера, состоящего из 15 атомов (в расчетах были учтены ближайшие к поглощающему атому никеля 15 атомов, представленные в таблице). С целью сопоставления расчеты на основе метода FMS с использованием кода FDMNES также были проведены для 15-атомного кластера.

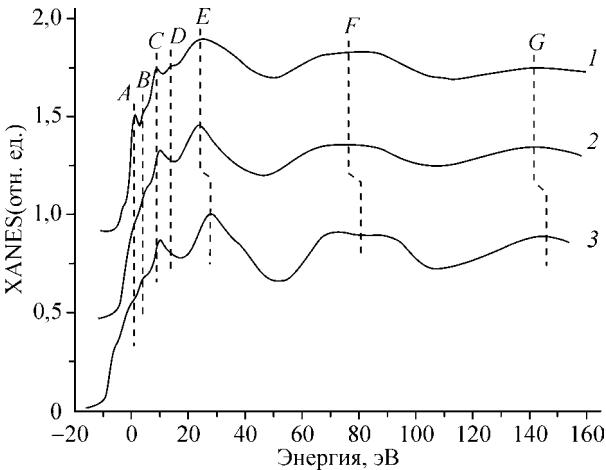
Координаты атомов комплекса Ni(EtOCS<sub>2</sub>)<sub>2</sub>

Атом	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	Атом	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>
Ni	0,00000	0,00000	0,00000	H	-1,55185	-3,48558	2,85217
S	-0,80999	0,15992	-2,05607	C	0,64951	3,71569	-3,05485
S	0,80999	-0,15992	2,05607	C	-0,64951	-3,71569	3,05485
S	-0,82286	-1,9653	0,6164	C	-0,43679	-4,37923	4,35243
S	0,82286	1,9653	-0,6164	C	0,43679	4,37923	-4,35243
C	0,00379	1,64619	-2,05607	H	0,47918	-4,52612	4,56138
C	-0,00379	-1,64619	2,05607	H	-0,47918	4,52612	-4,56138
O	-0,02422	2,40959	-3,11962	H	-0,83346	-3,87777	5,1151
O	0,02422	-2,40959	3,11962	H	0,83346	3,87777	-5,1151
H	0,25057	4,14333	-2,17726	H	0,86071	5,14624	-4,42974
H	-0,25057	-4,14333	2,17726	H	-0,86071	-5,14624	4,42974
H	1,55185	3,48558	-2,85217				



*Рис. 2.* Сопоставление экспериментального спектра поглощения за *K*-краем никеля в комплексе  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$  (1) с теоретическими спектрами, вычисленными с использованием программного кода FEFF8.2 (2, 3).

Теоретические спектры рассчитаны с учетом оставной вакансии, созданной электронным переходом (2) и без учета оставной вакансии (3).



*Рис. 3.* Сопоставление спектров поглощения за *K*-краем никеля в комплексе  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$ , рассчитанных программой FEFF8.2 с учетом различных моделей обменного потенциала — типа Хедина—Ландквиста (2) и типа Дирака—Хара (3).

В расчетах учтено наличие оставной вакансии, созданной электронным переходом. Экспериментальный  $\text{Ni}$  *K*-XANES спектр также показан (1).

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

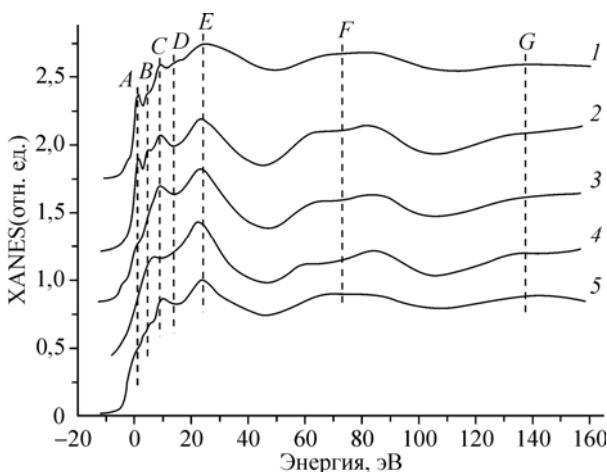
На рис. 2 приведено сопоставление экспериментального спектра поглощения за *K*-краем никеля в комплексе  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$  с теоретическими спектрами, вычисленными с помощью программного комплекса FEFF8.2. Теоретические XANES-спектры рассчитывали с учетом модели обменного потенциала типа Хедина—Ландквиста. Вычисления проводили для потенциала основного состояния электронной системы (без учета оставной вакансии, созданной электронным переходом; кривая 3 на рис. 2) и для потенциала возбужденного состояния (с учетом оставной вакансии, кривая 2 на рис. 2). Видно, что в случае *K*-края поглощения никеля в комплексе  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$  нет существенного различия между спектрами, вычисленными с учетом и без учета оставной вакансии.

Также было проведено исследование влияния типа обменного потенциала, используемого в расчетах, на форму  $\text{Ni}$  *K*-XANES-спектра. Спектры, вычисленные с использованием различных моделей обменного потенциала Хедина—Ландквиста и Дирака—Хара, показаны на рис. 3, из которого видно, что спектр XANES, рассчитанный с использованием модели потенциала типа Хедина—Ландквиста, дает лучшее согласие с экспериментом по энергетическому положению основных максимумов, тогда как в спектре, полученном на основе модели потенциала типа Дирака—Хара, энергетическое расстояние между основными особенностями спектра переоценено.

В целом, анализ рис. 2 и 3 позволяет сделать вывод, что для комплекса  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$  использование программного кода FEFF8.2 для расчета  $\text{Ni}$  *K*-XANES не приводит к хорошему согласию теоретических спектров с данными эксперимента. Хотя в теоретических спектрах, вычисленных с помощью FEFF8.2, и воспроизводятся основные детали эксперимента (*C*, *E*, *F*, *G*), однако невоспроизведенной остается низкоэнергетическая особенность *A*. Причиной этого, как уже говорилось выше, может быть тот факт, что в FEFF8.2 применяется *muffin-tin* приближение при расчете потенциалов, что не совсем корректно для плоских комплексов, содержащих пустоты, таких как  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$ , и может приводить к несогласию между теоретическими и экспериментальными данными.

С целью проверки данного предположения в работе были проведены расчеты ближней тонкой структуры *K*-края никеля в комплексе  $\text{Ni}(\text{EtOCS}_2)_2$  с помощью программного кода

*Рис. 4.* Сопоставление экспериментального Ni K-XANES-спектра Ni(EtOCS<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (1) с расчетными спектрами: 5 и 4 соответствуют спектрам XANES, вычисленным с помощью программ FEFF8.2 и FDMNES соответственно на основе метода полного многократного рассеяния в рамках *muffin-tin* приближения для формы потенциала; 3 — спектру, рассчитанному программой FDMNES по методу конечных разностей в *muffin-tin* приближении для расчета потенциала; 2 — расчету программой FDMNES на основе метода конечных разностей в полном потенциале (не в *muffin-tin* форме)



FDMNES, который позволяет проводить расчеты одним из двух методов: методом полного многократного рассеяния или методом конечных разностей. При расчете XANES-спектров на основе метода полного многократного рассеяния в расчетах используется *muffin-tin* приближение для формы потенциала. Тогда как при вычислении XANES на основе метода конечных разностей возможно проведение расчетов как в полном потенциале (не в *muffin-tin* форме), так и с использованием *muffin-tin* формы потенциала. В настоящей работе были проведены расчеты для всех перечисленных возможностей.

Спектры рентгеновского поглощения за K-краем никеля в Ni(EtOCS<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, рассчитанные программой FDMNES, приведены на рис. 4. Для сравнения на рис. 4 также показаны экспериментальный спектр и спектр, вычисленный с помощью программного кода FEFF8.2. Все теоретические спектры на рис. 4 рассчитаны с учетом оставной вакансии.

Ni K-XANES-спектры, вычисленные по методу полного многократного рассеяния в рамках *muffin-tin* приближения с помощью программ FDMNES и FEFF8.2, обозначены на рис. 4 кривыми 4 и 5 соответственно. Видно, что при расчете спектров XANES на основе метода полного многократного рассеяния с использованием *muffin-tin* приближения обе программы дают сходные результаты: как в спектре 4, так и в 5 не воспроизводится особенность A начальной области экспериментальной кривой 1. Отличие в высокоэнергетической области связано, вероятно, с различными методами учета "размазки" спектров.

Расчет по методу конечных разностей с *muffin-tin* формой потенциала (см. 3 на рис. 4) не привел к появлению особенности A в низкоэнергетической области спектра и к улучшению согласия между теорией и экспериментом.

На рис. 4 также показан Ni K-XANES-спектр (2), вычисленный на основе метода конечных разностей, но без использования *muffin-tin* приближения (расчет проводился в полном потенциале). Можно видеть, что в данном случае теория дает очень хорошее согласие с экспериментом: рассчитанный спектр воспроизводит как особенность (A), так и тонкие особенности эксперимента (B).

Все сказанное выше позволяет сделать вывод: для адекватного описания электронной структуры и, в частности, Ni K-XANES-спектра комплекса Ni(EtOCS<sub>2</sub>)<sub>2</sub> необходимо проведение расчетов в так называемом полном потенциале. Вычисления XANES с использованием *muffin-tin* приближения для формы потенциала, проведенные как по методу полного многократного рассеяния, так и по методу конечных разностей, не дают удовлетворительного согласия с экспериментом (в теоретических спектрах, в частности, не воспроизводится начальная область поглощения (пик A)). Проведенное исследование еще раз подчеркивает необходимость учета не-*muffin-tin* эффектов при анализе распределения электронных состояний у дна зоны проводимости — нижних свободных молекулярных орбиталей (LUMO — low unoccupied molecular orbital). Важность учета не-*muffin-tin* эффектов для комплексов на основе никеля, таких как Ni(acac)<sub>2</sub> и Ni(Pr<sub>2</sub>PhNC)<sub>4</sub>, была показана ранее в работе [14].

Авторы выражают благодарность к.ф.-м.н. С.Б. Эренбургу и к.ф.-м.н. Н.В. Бауску за помощь в работе по получению Ni K-XANES-спектра комплекса Ni(EtOCS<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кочубей Д.И., Бабанов Ю.А., Замараев К.И. и др. Рентгеноспектральный метод изучения структуры аморфных тел: EXAFS-спектроскопия. – Новосибирск: Наука, 1988.
2. Мазалов Л.Н. Рентгеновские спектры. – Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2003.
3. Smolentsev G., Soldatov A.V. // J. Synchrotron Rad. – 2006. – **13**, N 1. – P. 19 – 29.
4. Smolentsev G., Soldatov A.V., Feiters M.C. // Phys. Rev. B. – 2007. – **75**, N 14. – P. 144106-1-5.
5. Смоленцев Г.Ю., Солдатов А.В. Рентгеновская спектроскопия — анализ наноразмерной структуры вещества. – Ростов-на-Дону: Минитайп, 2006.
6. Мазалов Л.Н., Трубина С.В., Оглезнева И.М. и др. // Журн. структур. химии. – 2005. – **46**, № 3. – С. 554 – 557.
7. Мазалов Л.Н. // Там же. – 2003. – **44**, № 2. – С. 302 – 330.
8. Золотов Ю.А. Экстракция внутрикомплексных соединений. – М.: Наука, 1968.
9. Erenburg S.B., Bausk N.V., Zemskova S.M., Mazalov L.N. // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A. – 2000. – **448**, N 1-2. – P. 345 – 350.
10. Ankudinov A.L., Ravel B., Rehr J.J., Conradson S. // Phys. Rev. B. – 1998. – **58**, N 12. – P. 7565 – 7576.
11. Ankudinov A.L., Bouldin C.E., Rehr J.J. et al. // Ibid. – 2002. – **65**, N 10. – P. 104107-1-11.
12. Joly Y. // Ibid. – 2001. – **63**, N 12. – P. 125120-1-10.
13. Rehr J.J., Albers R.C. // Rev. Mod. Phys. – 2000. – **72**, N 3. – P. 621 – 654.
14. Soldatov A.V., Smolentsev G., Kravtsova A. et al. // Rad. Phys. Chem. – 2006. – **75**. – P. 1866 – 1868.